PLASMA CLEANING APPARATUS

Patent Number:

JP2002153832

Publication date:

2002-05-28

Inventor(s):

FUKUDA MASAYUKI; MURAKAMI NAOYA

Applicant(s):

SANYO ELECTRIC CO LTD

Requested Patent:

JP2002153832

Application Number: JP20000353715 20001121

Priority Number(s):

IPC Classification:

B08B9/08; B08B7/00; H01L21/304

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma cleaning apparatus for effectively removing stains stuck onto the inside of a chamber.

SOLUTION: This plasma cleaning apparatus is constituted so that the subject to be cleaned, which is disposed between a pair of electrodes 28, 29 arranged in an airtightly sealable chamber 2, is cleaned by plasma generated by impressing high frequency voltage between the electrodes 28, 29 while the chamber 2 is filled with a plasmareactive gas. The apparatus is provide with a cleaning means for cleaning the inside of the chamber 2 by filling the chamber 2 with the plasma-reactive gas and impressing the high frequency voltage between the electrodes 28, 29 in such a state that the subject to be cleaned is not housed in the chamber 2.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-153832 (P2002-153832A)

(43)公開日 平成14年5月28日(2002.5.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(容考)
B08B	9/08		B08B	9/08	3 B 1 1 6
	7/00			7/00	
H01L	21/304	6 4 5	H01L	21/304	6 4 5 C

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 13 頁)

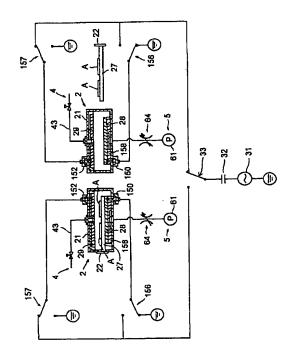
(21)出願番号	特顧2000-353715(P2000-353715)	(71)出願人	000001889 三 洋電機株式会社
(22)出願日	平成12年11月21日(2000.11.21)		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
(22) Million	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者	福田 正行
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(72)発明者	村上 直也
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(74)代理人	100085501
			弁理士 佐野 静夫
		Fターム(参	考) 3B116 AA33 AB53 BB89 CD42 CD43
		1	•

(54) 【発明の名称】 プラズマ洗浄装置

(57)【要約】

【課題】 チャンパ内に付着した汚れを効果的に除去で きるようにしたプラズマ洗浄装置を提供する。

【解決手段】 気密状態に密閉可能なチャンバ2内にプ ラズマ反応ガスを充填するとともにチャンバ2内に設け られた一対の電極28、29間に高周波電圧を印加して プラズマを発生させ、このプラズマにより、一対の電極 28、29間に配置された被洗浄物を洗浄するようにし たプラズマ洗浄装置において、チャンバ内2に被洗浄物 が収容されていない状態でチャンバ2内にプラズマ反応 ガスを充填するとともに一対の電極28、29間に高周 波電圧を印加してチャンバ2内をクリーニングするクリ ーニング手段を設けたことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 気密状態に密閉可能なチャンバ内にプラ ズマ反応ガスを充填するとともに前記チャンバ内に設け られた一対の電極間に髙周波電圧を印加してプラズマを 発生させ、このプラズマにより、前記一対の電極間に配 置された被洗浄物を洗浄するようにしたプラズマ洗浄装 置において、前記チャンバ内に被洗浄物が収容されてい ない状態で前記チャンバ内にプラズマ反応ガスを充填す るとともに前記一対の電極間に髙周波電圧を印加して前 けたことを特徴とするプラズマ洗浄装置。

【請求項2】 前記クリーニング手段が周期的にクリー ニングを行うことを特徴とする請求項1に記載のプラズ マ洗浄装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、回路基板等の被洗 浄物を発生させたプラズマにより洗浄するプラズマ洗浄 装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】との種のプラズマ洗浄装置は、気密状態 に密閉可能なチャンバ内にプラズマ反応ガスを充填する とともにチャンバ内に設けられた一対の電極間に高周波 電圧を印加してプラズマを発生させ、このプラズマによ り、一対の電極間に配置された被洗浄物を洗浄するよう に構成されている。

【0003】プラズマ洗浄装置では、被洗浄物を洗浄す 、る際に、被洗浄物に付着した接着剤や被洗浄物のかす等 がチャンバの内壁や被洗浄物を支持するトレイ等に付着 するため、周期的にチャンパ内のクリーニングを行う必 30 要がある。従来、チャンバ内の汚れは、アルコール等の 洗浄液をしみ込ませた布で拭き取られることが多かっ

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来の方法では、布が入りにくい細かい箇所の汚れを 除去するのが困難であった。また、汚れが透明な接着剤 の場合には目で見えにくく、粘性が高くて布で拭き取る のが困難であるため、充分に除去することができなかっ

【0005】本発明は上述した事情に鑑みてなされたも のであって、その目的は、チャンバ内に付着した汚れを 効果的に除去できるようにしたプラズマ洗浄装置を提供 することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ために、本発明は、気密状態に密閉可能なチャンバ内に プラズマ反応ガスを充填するとともに前記チャンバ内に 設けられた一対の電極間に高周波電圧を印加してプラズ マを発生させ、このプラズマにより、前記一対の電極間 50 すると、チャンバ本体21が開放されるとともに、基板

に配置された被洗浄物を洗浄するようにしたプラズマ洗 浄装置において、前記チャンパ内に被洗浄物が収容され ていない状態で前記チャンパ内にプラズマ反応ガスを充 填するとともに前記一対の電極間に高周波電圧を印加し て前記チャンバ内をクリーニングするクリーニング手段 を設けたことを特徴とするものである。

【0007】 このような構成によれば、チャンバ内に付 着した汚れがプラズマのエッチング作用により削り取ら れるため、布が入りにくい細かい箇所に付着した汚れも 記チャンバ内をクリーニングするクリーニング手段を設 10 除去することができる。また、汚れが透明な接着剤の場 合には、プラズマにより化学的に変化して粉末状の固定 として析出するため、視認可能になるとともに拭き取り 易くなり、容易に除去することができる。

> 【0008】なお、前記クリーニング手段が周期的にク リーニングを行うようにすると、チャンバ内が汚れの少 ない状態に保たれるため製品の不良率が低減する。ま た、チャンバ内を手作業でクリーニングする際に拭き取 る汚れの量が少なくなるため、手間が低減する。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的な実施形態 20 を図面を参照しながら説明する。図1及び図2は本実施 形態のプラズマ洗浄装置の全体構造を示した斜視図、図 3は本実施形態のプラズマ洗浄装置のチャンバの断面 図、図4は図3の要部拡大図、図5は本実施形態のプラ ズマ洗浄装置による基板の処理方法の説明図である。 【0010】図1及び図2に示すように、このプラズマ 洗浄装置1は、内部にプラズマが発生し、導入した基板 (被洗浄物) Aを洗浄する一対のチャンバ2と、一対の チャンバ2に交互に髙周波電圧を印加する電源部3と、 一対のチャンバ2にプラズマ反応ガスであるアルゴンガ ス及びリークのための窒素ガスを交互に供給するガス供 給装置4と、各チャンバ2内を真空状態にする一対の真 空吸引装置5と、一対のチャンバ2に対し基板Aを交互 に搬入・搬出する搬入・搬出機構6と、搬入・搬出機構 6に供給側マガジン7aを介して未処理基板Aaを供給 するマガジン供給部8と、搬入・搬出機構6から受け取 った処理基板Abを排出側マガジン7bを介して装置外 に排出するマガジン排出部9とを備えている。

【0011】各チャンバ2は、真空容器である箱状のチ 40 ャンバ本体21と、チャンバ本体21の前面に設けられ たフランジ状の蓋体22とを有している。蓋体22は、 両側に設けた蓋ガイド23によりチャンパ本体21に対 して進退自在に構成され、且つチャンバ本体21の側面 に設けたチャンバ開閉シリンダ (エアシリンダ)24の ピストンロッド25と連結板26で連結されている。 【0012】また、蓋体22の内側には、2枚の基板A を載置するトレイ27が取り付けられている。トレイ2 7は導電性材料から成り、蓋体22とともに進退する。 チャンバ開閉シリンダ24が駆動されて蓋体22が前進 Aを載置したトレイ27が引き出され、蓋体22が後退すると、トレイ27が押し込まれるとともにチャンバ本体21が閉塞される。

【0013】なお、チャンバ開閉シリンダ24は、図示 左側のチャンパ2では、その左側面に取り付けられ、右 側のチャンパ2では、その右側面に取り付けられている。また、図示しないが、チャンパ本体21と蓋22の間には、チャンパ2の気密性を保持すべく、Oリング等のシール部材が介在している。

【0014】また、図3に示すように、各チャンバ2内 10には、下方に配された矩形板状の下部電極28と、その上方に配された矩形板状の上部電極29とが設けられている。下部電極28は、上記のトレイ27の下方に位置するように配され、矩形板状の整流部材158を介してチャンバ本体21の下部内面に取り付けられるとともに、チャンバ本体21の下面に固着された接続端子150と導通している。なお、整流部材158は、絶縁性の材料から成り、下部電極28の真下に位置するとともに下部電極28とほぼ整合するように形成されている。一方、上部電極29は、チャンバ本体21の上部内面に、20矩形板状のホルダー151を介して取り付けられるとともに、チャンバ本体21の上面に固着された接続端子152と導通している。

【0015】トレイ27は、チャンバ本体21に出入りする際には下部電極28との間に空隙を存した状態で水平方向に移動し、チャンバ本体27内に完全に収納される直前に水平方向に移動しつつ下降して下部電極28と接するようになっている。

【0016】図4に示すように、各チャンバ本体21の 頂壁にはガス導入孔153が形成されており、このガス 30 っている。 導入孔153は、ホルダー151を貫通して上部電極2 【0022 9に達し、上部電極29の下部で径が拡大して上部電極 19の下面に開口している。ガス導入孔153の下端部 供給管42 にはプレート154が嵌め込まれており、このプレート し、各アリ 154には厚さ方向に貫通するガス噴出孔155が複数 個形成されている。また、ガス導入孔153の上端に る。両アリは、後述するガス導入管43が連通接続されている。 構成された

【0017】また、各チャンバ本体21の底壁には下部 電極28の中央部に対向するようにガス排出孔159が 形成されており、整流部材158の底面には、ガス排出 40 孔159に連通した溝状のガス通路160が形成されて いる。このガス通路160は格子状に形成されていて、整流部材158の四側面に開口している。整流部材158の中央部にはガス通路160に連通した凹部161が 形成されていて、この凹部161はガス排出孔159と 整合している。

【0018】電源部3は、高周波電源31と、自動整合 一対のチャンバ2に交互にアルゴンガスを導入する場合 器32と、真空リレー33とを有している。真空リレー には、両窒素側切替バルブ50が「閉」となり、両アル 33は、図示しない制御装置(パソコン)に接続され、 ゴン側切替バルブ49の一方が「開」、他方が「閉」と この制御装置の切替指令により、一対のチャンバ2に対 50 なる。また、後述するリークの為に窒素ガスを導入する

し高周波電源31を交互に切り替える。また、真空リレー33は、真空リレー156を介してチャンパ2の下面の接続端子150に接続され、真空リレー157を介してチャンパ2の上面の接続端子152に接続されている。

【0019】真空リレー156、157は上記制御装置 に接続されており、制御装置の切替指令により、上部電極29または下部電極28のいずれか一方を高周波電源31に接続し、下部電極28または上部電極29のいずれか他方をグランド電位に接続する。

【0020】自動整合器32は、チャンバ2に印加した高周波の反射波による干渉を防止するものであり、この場合には、一対のチャンバ2に対し1台の自動整合器32を対応させているが、各チャンバ2に対しそれぞれ1台の自動整合器32を対応させるようにしてもよい。かかる場合には、高周波電源31、真空リレー33、自動整合器32の順で結線される。

【0021】ガス供給装置4は、図外のアルゴンガスボンベに連なるアルゴンガス供給管41と、図外の窒素ガスが立てに連なるで素ガス供給管42と、各チャンパ2に連なる一対のガス導入管43と、アルゴンガス供給管41及び窒素ガス供給管42と一対のガス導入管43とを接続するガス切替管44とを有している。アルゴンガス供給管41及び窒素ガス供給管42には、それぞれマニュアルで操作されるアルゴンガス供給がルブ45及び窒素ガス供給がルブ46が設けられている。また、アルゴンガス供給管41にはマスフローコントローラ47が介設され、また窒素ガス供給管42にはパージ流量計48が介設され、それぞれガス流量を制御できるようになっている。

【0022】ガス切替管44は、アルゴンガス供給管4 1に連なる2本のアルゴン側分岐管44aと、窒素ガス 供給管42に連なる2本の窒素側分岐管44bとを有 し、各アルゴン側分岐管44aと各窒素側分岐管44b の合流部分に上記の各ガス導入管43が接続されてい る。両アルゴン側分岐管44aには、それぞれ電磁弁で 構成されたアルゴン側切替バルブ49が介設され、ま た、両窒素側分岐管44bには、それぞれ電磁弁で構成 された窒素側切替バルブ50が介設されている。一対の アルゴン側切替バルブ49及び一対の窒素側切替バルブ 50は制御装置に接続され、制御装置の切替指令によ り、開閉する。この場合、アルゴンガスのガス量を精度 良く制御するため、上記のマスフローコントローラ47 は、制御信号に基づいて、フィードバック制御される。 【0023】アルゴンガス供給バルブ45及び窒素ガス 供給バルブ46は、それぞれ常時「開」となっており、 一対のチャンバ2に交互にアルゴンガスを導入する場合 には、両窒素側切替バルブ50が「閉」となり、両アル ゴン側切替バルブ49の一方が「開」、他方が「閉」と

場合には、両アルゴン側切替バルブ49が「閉」とな り、両窒素側切替バルブ50の一方が「開」、他方が 「閉」となる。なお、図中の符号51は、プラズマ反応 ガスとして、アルゴンガスの他、酸素ガスを導入可能と する場合 (仮想線にて図示) に、開閉される開閉電磁弁 である。

【0024】各真空吸引装置5は、真空ポンプ61と、 真空ポンプ61と各チャンバ2を接続する真空配管62 とを有している。真空配管62には、チャンバ2側から 真空計63、圧力調整バルブ64及びメインバルブ65 10 が介設されている。メインバルブ65は電磁弁で構成さ れており、メインバルブ65が「開」状態で、フレキシ ブル管67を介して真空配管62と真空ポンプ61とが 連通し、チャンバ2内の真空引きが行われる。

【0025】搬入・搬出機構6は、両チャンバ2と、マ ガジン供給部8及びマガジン排出部9との間で、基板A を搬送する基板搬送機構12を有するとともに、基板搬 送機構12と両チャンバ2との間で基板Aを移載するチ ャンバ側移載機構13と、基板搬送機構12と供給側・ 排出側両マガジン7a、7bとの間で基板Aを移載する 20 マガジン側移載機構14とを有している。

【0026】供給側マガジン7aに収容されている未処 理基板Aaは、マガシン側移載機構14により基板搬送 機構12に移載され、基板搬送機構12により下動位置 からチャンバ2近傍の上動位置まで搬入される。ここ で、チャンバ側移載機構13が駆動され、未処理基板A aを基板搬送機構12からチャンバ2のトレイ27に移 載する。一方、処理基板Abは、チャンバ側移載機構1 3によりトレイ27から基板搬送機構12に移載され、 基板搬送機構12により上動位置から供給・排出側両マ 30 1載置部77を該当する未処理基板Aaに位置合わせ ガジン7a、7b近傍の下動位置まで搬出される。ここ で、マガシン側移載機構14が駆動され、処理基板Ab を基板搬送機構12から排出側マガジン7bに移載す

【0027】基板搬送機構12は、図外の機台に取り付 けられた基板昇降装置71と、基板昇降装置71に取り 付けられた基板Y動装置72と、基板Y動装置72によ り図示の前後方向に移動する基板載置ステージ73とを 有している。

【0028】基板載置ステージ73は、ベースプレート 40 75上に、相互に平行に配設した3条の突条76によ り、上段及び下段にそれぞれ2枚の基板Aを棚板状に載 置できるようになっている。すなわち、3条の突条76 には、それぞれ上下に内向きの受け部(図示省略)が突 出形成されており、この受け部により上段に2枚の未処 理基板Aaを載置する前後一対の第1載置部77が、下 段に2枚の処理基板Abを載置する前後一対の第2載置 部78が構成されている。すなわち、供給側マガジン7 aから移載される未処理基板Aaは第1載置部77に載 置され、各チャンバ2のトレイ27から移載される処理 50 降装置71及び基板Y動装置72を駆動して、トレイ2

基板Abは第2載置部78に載置される。

【0029】基板Y動装置72は、後述する基板昇降装 置71の昇降ブロック85に取り付けられており、減速 機付きの基板Y動モータ80と、基板Y動モータ80に より回転するボールネジ81を有している。図示では省 略されているが、基板載置ステージ73は、基板昇降装 置71の昇降ブロック85との間で前後方向に進退自在 に構成(案内)されており、基板載置ステージ73の一 部に螺合するボールネジ81が、基板Y動モータ80に より正逆回転することにより、基板載置ステージ73が 昇降ブロック85に対し、前後方向に進退する。

【0030】基板昇降装置71は、減速機付きの基板昇 降モータ83と、基板昇降モータ83により回転するボ ールネジ84と、ボールネジ84に螺合する雌ネジ部 (図示省略)が形成された昇降ブロック85とを有して いる。上述のように、基板載置ステージ73及び基板Y 動装置72は昇降ブロック85に支持されており、昇降 ブロック85は、基板昇降モータ83を介して正逆回転 するボールネジ84により、昇降する。なお、基板昇降 装置71を基板Y動装置72に取り付け、基板昇降装置 71で基板載置ステージ73を昇降させ、基板Y動装置 72で基板昇降装置71及び基板載置ステージ73を前 後動させるようにしてもよい。

【0031】供給側マガジン7aから未処理基板Aaを 受け取る場合には、供給側マガジン7aの該当する未処 理基板Aaの位置に、基板載置ステージ73の第1載置 部77が合致するように、基板昇降装置71及び基板Y 動装置72を駆動する。具体的には、基板載置ステージ 73をホーム位置から後退及び上昇させ、先ず一方の第 し、さらに基板載置ステージ73の後退(前進)によ り 他方の第1載置部77を該当する次の未処理基板A aに位置合わせする。なお、詳細は後述するが、供給側 マガジン7aは昇降するようになっており、未処理基板 Aaの移載高さ位置(レベル)は、特定の位置に設定さ れている。

【OO32】また、処理基板Abを排出側マガジン7b に受け渡す場合には、同様に第2載置部78の2枚の処 理基板Abを、それぞれ排出側マガジン7bの該当する 収容位置に位置合わせする。この場合も、排出側マガジ ン7 bは昇降するようになっており、処理基板Abの移 越高さ位置(上記の移載高さ位置とは異なるが)は、特 定の位置に設定されている。なお、基板載置ステージ7 3 に対し供給側マガジン7 a 及び排出側マガジン7 b は、その左右両側に近接して配置されているため(図示 では離れているが)、基板Aの移載に際し基板載置ステ ージ73を左右方向に移動させる必要はない。

【0033】一方、未処理基板Aa及び処理基板Abを チャンバ2との間でやりとりする場合には、先ず基板昇

7上の処理基板Abと第2載置部78を位置合わせし、 2枚の処理基板Abを第2載置部78に同時に受け取る (詳細は後述する)。次に、基板載置ステージ73をわ ずかに下降させ、第1載置部77の未処理基板Aaとト レイ27 (の上面) とを位置合わせし、2枚の未処理基 板Aaをトレイ27上に受け渡す。なお、この場合も、 基板載置ステージ73に対し、両チャンバ2は、その左 右両側に近接して配置されているため(図示では離れて いるが)、基板Aの移載に際し基板載置ステージ73を 左右方向に移動させる必要はない。

【0034】マガシン側移載機構14は、未処理基板A aを供給側マガジン7aから基板搬送機構12に送り出 す供給側シリンダ91と、処理基板Abを基板搬送機構 12から排出側マガジン7bに送り込む排出側シリンダ 92とを有している。供給側シリンダ91は図外の機台 に取り付けられており、そのピストンロッド94によ り、該当する未処理基板Aaの端を押して、これを供給 側マガジン7aから基板搬送機構12に送り出す。

【0035】排出側シリンダ92は、図外の機台に取り 付けられ、マガジン供給部8及びマガジン排出部9間に 亘って延在するシリンダ本体95と、シリンダ本体95 により左右方向に移動する送り爪装置96とを有してい る。送り爪装置96は、ハウジング内にモータ等のアク チュエータを収容するとともに、アクチュエータにより 上下動する送り爪97を有している。アクチュエータに より送り爪97を所定の下動位置に移動させ、シリンダ 本体95により送り爪装置96を図示左方に移動させる ことにより、送り爪97が処理基板Abの端を押して、 これを基板搬送機構12から排出側マガジン7bに送り 込む。

【0036】供給側シリンダ91のピストンロッド94 の高さ位置及び排出側シリンダ92の送り爪97の高さ 位置は、上記の移載高さ位置に設定され、且つ、ピスト ンロッド94側の移載高さ位置と送り爪97の移載高さ 位置とは、基板載置ステージ73の第1載置部77と第 2 置部78 との間の段差分の差を有している。このた め、基板載置ステージ73の第1載置部77と第2載置 部78を、それぞれ両移載高さ位置に位置合わせしてお いて、先ず排出側シリンダ92を駆動することで、処理 り込まれ、次に供給側シリンダ91を駆動すれば、未処 理基板Aaが供給側マガジン7aから第1載置部77に 送り出される。

【0037】なお、詳細は後述するが、供給側マガジン 7aから送り出されるべき任意の 1 枚の未処理基板 A a の選択、及び処理基板Abが送り込まれるべき排出側マ ガシン7 bの任意の1つの収容位置(何段目か)の選択 は、マガジン供給部8において供給側マガジン7 a を昇 降させること、及びマガジン排出部9において排出側マ ガジン7bを昇降することで行われる。

【0038】チャンバ側移載機構13は、一対のチャン バ2、2間に亘って左右方向に延在するガイドケース1 01と、ガイドケース101の一方の端に取り付けられ た減速機付きのX動モータ102と、X動モータ102 により回転するボールネジ103と、ボールネジ103 により左右方向に移動する移載爪装置104とを有して いる。移載爪装置104は、ハウジング内にモータ等の アクチュエータを収容するとともに、アクチュエータに より上下動する移載爪105を有している。

8

【0039】移載爪105の先端は二股に形成されてお 10 り、トレイ27と基板搬送機構12との間で、2枚の基 板Aを同時に移載可能に構成されている。移載爪装置1 04は、ハウジングの部分でガイドケース101により 左右方向の移動をガイドされており、X動モータ102 を介してボールネジ103が正逆回転することにより、 移載爪装置104はガイドケース101に沿って左右方 向に移動する。また、アクチュエータの正逆駆動によ り、移載爪105が上下動する。

【0040】基板搬送機構12が第1載置部77に未処 20 理基板Aaを載置してチャンバ2に臨むと、X動モータ 102が駆動されて移載爪装置104をトレイ27の端 位置に移動させ、続いて移載爪装置104が駆動されて 移載爪105をトレイ27の上面位置まで下動させる。 次に、X動モータ102が駆動されて移載爪装置104 を基板搬送機構12側に移動させる。これにより、移載 爪105がトレイ27上の2枚の処理基板Abを押すよ うにして移動させ、処理基板Abを基板搬送機構12の 第2載置部78に受け渡す。次に、移載爪105を未処 理基板Aaに合わせてわずかに上動させた後、移載爪装 30 置104をトレイ27側に移動させることにより、移載 爪105が2枚の未処理基板Aaを第1載置部77から トレイ27上に受け渡す。

【0041】マガジン供給部8は、複数個の供給側マガ ジン7aを載置可能な供給側マガジン載置台111と、 供給側マガジン載置台111から供給された供給側マガ ジン7aを昇降させる供給側昇降装置112と、供給側 マガジン7aを供給側マガジン載置台111から供給側 昇降装置112に送り込む供給側マガジンシリンダ11 3とを有している。一方、供給側マガジン7aは、複数 基板Abが第2載置部78から排出側マガジン7bに送 40 段に亘って基板Aを棚板状に収容できるように、両側壁 にそれぞれ複数の受け部が形成されている。そして、こ のように構成された供給側マガジン7 a は、未処理基板 Aaを収容した状態で、前面を基板搬送機構12側に向 けて配設されている。なお、排出側マガジン7bは、こ の供給側マガジン7 a と全く同一のものである。

> 【0042】供給側マガジンシリンダ113は、供給側 昇降装置112の供給側マガジン7aが空になったとき に、そのピストンロッド115により、供給側マガジン 載置台111に載置されている複数個の供給側マガジン 50 7 a を順に送り込んで、新たに供給側マガジン7 a を供

給側昇降装置112に供給する。なお、供給側マガジン 世間台111に新たに投入される供給側マガジン7a は、ピストンロッド115が後退した状態で、供給側マ ガジン載置台111のピストンロッド115側に投入さ れる。

【0043】供給側昇降装置112は、減速機付きのマ ガジン昇降モータ116と、マガジン昇降モータ116 により回転するボールネジ117と、ボールネジ117 に螺合する雌ネジ部 (図示省略) が形成された昇降ブロ ック118とを有している。未処理基板Aaを送り出す 10 供給側マガジン7aは、昇降ブロック118に支持され ており、昇降ブロック118は、マガジン昇降モータ1 16を介して正逆回転するボールネジ117により、昇 降する。

【0044】供給側昇降装置112に送り込まれた供給 側マガジン7aは適宜昇降し、その際上記の供給側シリ ンダ91が、供給側マガジン7aに収容した未処理基板 Aaを1枚ずつ送り出してゆく。この場合、未処理基板 Aaを、供給側マガジン7aの最下段のものから順に送 り出してゆく。すなわち、最初に最下段の未処理基板A aを移載高さ位置に位置合わせしてこれを送り出し、次 に下から2段目の未処理基板Aaを移載高さ位置に位置 合わせ(下降)してこれを送り出す。このようにして、 最上段の未処理基板Aaを送り出したところで、供給側 マガジン7aが空になるため、これをさらに下降させて マガジン移送部10に受け渡すようにしている。

【0045】マガジン排出部9は、マガジン供給部8と 同様に、複数個の排出側マガジン7 b を載置可能な排出 側マガジン載置台121と、排出側マガジン7bを昇降 なった排出側マガジン7bを排出側昇降装置122から 排出側マガジン載置台121に送り込む排出側マガジン シリンダ123とを有している。排出側マガジンシリン ダ123は、そのピストンロッド125により、満杯に なった排出側マガジン7bを順次排出側マガジン載置台 121に送り込んでゆく。

【0046】排出側昇降装置122は、供給側昇降装置 112と同様に、マガジン昇降モータ126と、ボール ネジ127と、昇降ブロック128とを有している。処 ブロック128に支持されており、昇降ブロック128 は、マガジン昇降モータ126を介して正逆回転するボ ールネジ127により、昇降する。この場合、空の排出 側マガジン7 bは、マガジン移送部10を介して供給側 昇降装置112から供給される。

【0047】そして、この場合も、排出側昇降装置12 2の排出側マガジン7bは適宜昇降し、その際上記の排 出側シリンダ92が、排出側マガジン7bに処理基板A bを1枚ずつ送り込んでゆく。この場合には、排出側マ ガジン7 bを間欠上昇させながら、処理基板Abを最上 50 勢を変える必要がない。

段から順に収容してゆくことが好ましい。なお、供給側 昇降装置112及び排出側昇降装置122の各昇降ブロ ック118、128は、各マガジン7a、7bを載置す るプレート部位118a、128aの中央が、広く 「コ」字状に切り欠かれており、後述するチャック装置 131が上下方向にすり抜け得るようになっている。 【0048】マガジン移送部10は、空マガジン(空に なった供給側マガジン7a)7cを受け取って把持する チャック装置131と、先端部でチャック装置131を 支持する回転アーム132と、回転アーム132を基端 部を中心に回転させる減速機付きの回転モータ133と を有している。回転モータ133は、図外の機台に固定 されており、回転アーム132を水平面内において角度 180度、往復回転(回動)させ、チャック装置131 に把持した空マガジン7cをマガジン供給部8からマガ ジン排出部9に移送する。チャック装置131は、上面 に空マガジン7 cが載置されるハウジング135と、ハ ウジング135内に収容したシリンダ(図示省略)と、 ハウジング135の上面から突出しシリンダにより離接 20 方向に相互に移動する一対のチャック136とを有して いる。

10

【0049】一対のチャック136を離間する方向に開 いておいて、供給側昇降装置112に臨ませ、この状態 で、供給側昇降装置112に載置されている空マガジン 7 cを下降させると、昇降ブロック118のプレート部 位118aがチャック136を上側から下側にすり抜け たところで、空マガジン7cがハウジング135の上面 に載る。これにより、空マガジン7cが供給側昇降装置 112からマガジン移送部10に受け渡される。とこ させる排出側昇降装置122と、処理基板Abで満杯に 30 で、一対のチャック136を閉じるようにして、空マガ ジン7cを把持する。空マガジン7cがチャック装置1 31に不動に把持されたら、回転アーム132を回動さ せて空マガジン7 cを排出側昇降装置122に臨ませ

【0050】このとき、排出側昇降装置122の昇降ブ ロック128には排出側マガジン7bは無く、また、昇 降プロック128は下降位置にある。空マガジン7cが 排出側昇降装置122に臨んだら、チャック装置131 による把持状態を解除し、昇降ブロック128を上昇さ 理基板Abが送り込まれる排出側マガジン7bは、昇降 40 せる。昇降ブロック128が上昇し、そのブレート部位 128aがチャック136を下側から上側にすり抜ける と、昇降ブロック128が空マガジン7cを自動的に受 け取ってそのまま上昇する。なお、マガジン移送部10 により、マガジン供給部8からマガジン排出部9に移送 された空マガジン7 cは、マガジン排出部9で排出側マ ガジン7bとして利用されるが、空マガジン7cは回転 して移送されるため、その前部が搬入・搬出機構6側に 向いた姿勢で、マガジン排出部9に受け渡される。この ため、移送の前後で別の装置により空マガジン7 cの姿

【0051】なお、搬入・搬出機構6、マガジン供給部 8、マガジン排出部9及びマガジン移送部10における モータやシリンダ等のアクチュエータは制御装置に接続 され、制御装置により総括的に制御される。ここで、図 5を参照して、各部の動作を順を追って説明する。

【0052】同図において、左側のチャンバ2aは基板 Aの洗浄工程にあり、右側のチャンパ2bは基板Aの搬 入・搬出工程にあるものとする。右側のチャンバ2bで 洗浄済みの基板(処理基板Ab)Aが外部に引き出され る動きに合わせて、搬入・搬出機構6は、マガジン供給 10 部8から未処理基板Aaを受け取って、右側のチャンバ 2 b の近傍まで搬送する。ととで、搬入・搬出機構6 は、右側のチャンバ2bから処理基板Abを受け取り、 続いて未処理基板A a を右側のチャンバ2 b に受け渡 す。

【0053】右側のチャンバ2bは、未処理基板Aaを 受け取ると、これを内部に持ち込む。同時に、搬入・搬 出機構6は、処理基板Abを搬送してマガジン排出部9 に受け渡す。右側のチャンバ2bが未処理基板Aaを内 部に持ち込むと、真空リレー33が右側のチャンバ2b 20 基板Aの表面が改質される。 に切り替えられて右側のチャンバ2bが洗浄工程に移行 する。これと同時に、左側のチャンバ2aは、窒素ガス によるリークを経て搬入・搬出工程に移行する。

【0054】そして今度は、左側のチャンバ2aで処理 基板Abが引き出される助きに合わせて、搬入・搬出機 構6は、マガジン供給部8から未処理基板Aaを受け取 って、左側のチャンバ2 a に搬入する。そして、真空リ レー33が左側のチャンパ2aに切り替えられて左側の チャンパ2 aが洗浄工程に移行する。一方、右側のチャ ンバ2bは、窒素ガスによるリークを経て搬入・搬出工 30 程に移行する。

【0055】すなわち、左右のチャンバ2a、2bは交 互に搬入・搬出工程と洗浄工程とを繰り返し、これに台 わせて搬入・搬出機構6は左右のチャンバ2 a、2 b に 対し、未処理基板Aa及び処理基板Abを交互に搬入・

【0056】洗浄工程について詳細に説明すると、基板 AにRIE方式の処理を行う場合には、制御装置の操作 入力部でRIE方式を指定する。すると、真空リレー1 56が高周波電源31側に切り替えられ、真空リレー1 57がグランド電位側に切り替えられる。チャンバ2内 に基板Aが搬入されると、真空吸引装置5が駆動されて チャンバ2内が真空状態にされ、ガス導入管43を介し てガス導入孔153内にプラズマ反応ガスが供給され

【0057】ガス導入孔153に供給されたプラズマ反 応ガスは、プレート154のガス噴出孔155を介して チャンバ2内に噴出する。そして、高周波電源31が駆 動され 下部電極28に高周波電力が供給される。これ によってチャンバ2内にプラズマが発生し、プラズマ中 50 ーニングを行う場合について、図6を参照しながら説明

のプラスイオンが主として負に帯電した下部電極28に 引き寄せられるため、プラスイオンが基板Aの表面に衝 突して基板Aの表面の不純物を削り取る。

【0058】一方、基板AにPE方式の処理を行う場合 には、制御装置の操作入力部でPE方式を指定する。す ると、真空リレー156がグランド電位側に切り替えら れ、真空リレー157が高周波電源31側に切り替えら れる。チャンバ2内に基板Aが搬入されると、真空吸引 装置5が駆動されてチャンバ2内が真空状態にされ、ガ ス導入管43を介してガス導入孔153内にプラズマ反 応ガスが供給される。

【0059】ガス導入孔153に供給されたプラズマ反 応ガスは、プレート154のガス噴出孔155を介して チャンバ2内に噴出する。そして、髙周波電源31が駆 動され、上部電極29に髙周波電力が供給される。これ によってチャンバ2内にプラズマが発生し、プラズマ中 のプラスイオンは主として負に帯電した上部電極29に 引き寄せられ、トレイ27上の基板Aの表面にはプラス イオンはあまり衝突せず、主としてラジカルが衝突し、

【0060】なお、チャンバ2内に噴出したプラズマ反 応ガスは、各基板Aの表面に当たった後に各基板Aの全 周方向に拡散し、トレイ27、下部電極28の各側面に 沿って下方へ流れ、図4に矢印で示す如く、整流部材1 58の各側面に開口した通路160に流入し、凹部16 1、ガス排出孔159を介して真空配管62に流入す る。

【0061】また、本実施形態のプラズマ洗浄装置は、 周期的にチャンバ2内をクリーニングするクリーニング 手段を備えており、このクリーニング手段は制御装置の メモリ内に格納されたプログラムにより構成されてい る。このクリーニング手段は、チャンバ2内に基板Aが 収容されていない状態でチャンバ2内にプラズマ反応ガ スを充填するとともに、電極28、29間に高周波電圧 を印加して空放電させるもので、発生したプラズマによ るエッチング作用でチャンバ2内がクリーニングされ る。

【0062】このクリーニング手段は、①一回の洗浄処 理が終了する毎にクリーニングを行う場合、②一つの供 40 給側マガジン7aに収容された全ての未処理基板Aaの 洗浄処理が終了する毎にクリーニングを行う場合、**③**あ らかじめ設定された枚数の未処理基板 A a の洗浄処理が 終了する毎にクリーニングを行う場合、④クリーニング を行わない場合、のいずれかをオペレータが選択できる ようになっている。すなわち、オペレータは、プラズマ 洗浄装置の自動運転の開始に先立って、図外のディスプ レイ装置の画面に表示された上記の①~④のメニューの うち、所望のものを選択して入力する。

【0063】まず、一回の洗浄処理が終了する毎にクリ

する。プラズマ洗浄装置の自動運転がスタートすると、 チャンバ2が密閉され、チャンバ2内にプラズマ反応ガ スが充填されるとともに空放電が行われ、チャンパ2内 がクリーニングされる(ステップ#10)。次に、供給 側マガジン7aから未処理基板Aaがチャンバ2内に搬 送され、(ステップ#20)、プラズマ処理が行われて 基板Aが洗浄された後(ステップ#30)、チャンバ2 から処理基板Abが取り出される(ステップ#40)。

13

【0064】そして、供給側マガジン7a内の未処理基 板Aaが無くなるまでステップ#10~#40の処理が 10 繰り返される。すなわち、一回の洗浄工程の終了毎にチ ャンバ2内のクリーニングが行われる。そして、供給側 マガジン7a内の未処理基板Aaが無くなると、空の供 給側マガジン7aがマガジン供給部8から取り除かれ、 未処理基板Aaを収容した供給側マガジン7aがマガジ ン供給部8に供給される(ステップ#50~#70)。 全ての供給側マガジン7 a の処理が終了すると、プラズ マ洗浄装置の自動運転が停止する。

【0065】次に、一つの供給側マガジン7aに収容さ れた全ての未処理基板Aaの洗浄処理が終了する毎にク リーニングを行う場合について、図7を参照しながら説 明する。プラズマ洗浄装置の自動運転がスタートする と、チャンバ2が密閉され、チャンバ2内にプラズマ反 応ガスが充填されるとともに空放電が行われ、チャンバ 2内がクリーニングされる(ステップ#110)。次 に、供給側マガジン7 aから未処理基板A a がチャンバ 2内に搬送され、(ステップ#120)、プラズマ処理 が行われて基板Aが洗浄された後(ステップ#13 0)、チャンバ2から処理基板Abが取り出される(ス テップ#140)。

【0066】そして、供給側マガジン7a内の未処理基 板Aaが無くなるまでステップ#120~#140の処 理が繰り返される。供給側マガジン7a内の未処理基板 Aaが無くなると、空の供給側マガジン7aがマガジン 供給部8から取り除かれ、未処理基板Aaを収容した供 給側マガジン7aがマガジン供給部8に供給され(ステ ップ#150~#170)、ステップ#110に戻る。 全ての供給側マガジン7aの処理が終了するまで上述し た動作が繰り返される。すなわち、一つの供給側マガジ ン7 a の処理が終了する毎にチャンパ2内のクリーニン 40 め、汚れを視認することができるとともに、汚れの拭き グが行われる。全ての供給側マガジン7aの処理が終了 すると、プラズマ洗浄装置の自動運転が停止する。

【0067】次に、あらかじめ設定された枚数の未処理 基板Aaの洗浄処理が終了する毎にクリーニングを行う 場合について、図8を参照しながら説明する。プラズマ 洗浄装置の自動運転がスタートすると、チャンバ2が密 閉され、チャンバ2内にプラズマ反応ガスが充填される とともに空放電が行われ、チャンバ2内がクリーニング される(ステップ#210)。次に、供給側マガジン7 aから未処理基板Aaがチャンバ2内に搬送され、(ス 50 状の汚れが粉末状に固体化して折出する。

テップ#220)、プラズマ処理が行われて基板Aaが 洗浄されるとともに処理枚数がカウントされる(ステッ プ#230)。洗浄が終了すると、チャンパ2から処理 基板Abが取り出される(ステップ#240)。

【0068】そして、未処理基板Aaの処理枚数の累計 があらかじめ設定された枚数に達するまでステップ#2 20~#240の処理が繰り返される。処理枚数の累計 が設定枚数に達すると、処理枚数のカウントがリセット されてステップ#210に戻り(ステップ#250~# 270)、チャンバ2内がクリーニングされる。そし て、再び処理枚数の累計が設定枚数に達するまでステッ プ#220から#240までの動作が繰り返される。す なわち、あらかじめ設定された枚数の未処理基板Aaの 処理が終了する毎にチャンバ2内のクリーニングが行わ れる。

【0069】供給側マガジン7a内の未処理基板Aaが 無くなると、空の供給側マガジン7aがマガジン供給部 8から取り除かれ、未処理基板Aaを収容した供給側マ ガジン7aがマガジン供給部8に供給され(ステップ# 20 250、#280、#290)。、ステップ#260に 戻る。そして、全ての供給側マガジン7aの処理が終了 すると、プラズマ洗浄装置の自動運転が停止する。

【0070】とのように、本実施形態のプラズマ洗浄装 置では、周期的に行われる空放電でチャンバ2内が自動 的にクリーニングされるため、チャンバ2内は汚れの少 ない状態に保たれるが、被洗浄物の種類によっては、と れで充分に汚れを除去しきれないこともある。そこで、 本実施形態では、一つの供給側マガジン7 a に収容され た全ての基板Aaの洗浄処理が終了する毎に、チャンパ 30 2を自動的に開くとともに、ディスプレイ装置に、手作 業でトレイ27をクリーニングするようにオペレータに 要求する表示を行うモードにすることもできるようにな っている。

【0071】また、この場合、被洗浄物が、透明な接着 剤等の液体状の汚れを生じるものである場合には、ディ スプレイ装置の表示に先立って、チャンバ2内で空放電 が行われるように設定することもできるようになってい る。このようにすると、トレイ27に透明な接着剤が付 着している場合には、粉末状に固体化して析出するた 取りが容易となる。

【0072】図9、10は、そのような場合のプラズマ 洗浄装置の動作を示しており、ステップ#310~#3 50の処理は図7のステップ#110~#150の処理 と同じである。そして、供給側マガジン7 a 内の未処理 基板Aaが無くなると、液体状の汚れの設定が行われて いる場合には、チャンバ2内にプラズマ反応ガスが充填 されるとともに空放電が行われる(ステップ#360、 #370)。これによって、トレイ27に付着した液体

【0073】そして、チャンバ2からトレイ27が自動 的に突出し(ステップ#380)、ディスプレイ装置の 画面にトレイ27のクリーニングを要求するメッセージ 表示され、図外のブザーが鳴動し、図外のシグナルタワ ーが点灯する (ステップ#390)。 オペレータがアル コールをしみ込ませた布でトレイ27をクリーニングし (ステップ#400)、ディスプレイ装置に表示された クリーニング完了ボタンを選択入力すると (ステップ# 410)、トレイ27がチャンパ2内に引き込まれる (ステップ#420)。

【0074】そして、空の供給側マガジン7aがマガジ ン供給部8から取り除かれ、未処理基板Aaを収容した 供給側マガジン7aがマガジン供給部8に供給される (ステップ#430、#440)。そして、ステップ# 310に戻り、チャンバ2内で空放電が行われ、トレイ 27上の拭き残し汚れやアルコール成分が除去される。 なお、ステップ#360で液体状の汚れの設定が行われ ていない場合には、ステップ#370のチャンバ2内の 空放電が行われず、ステップ#380に進む。全ての供 給側マガジン7aの処理が終了するまで上述した動作が 20 繰り返され、全ての供給側マガジン7aの処理が終了す ると、プラズマ洗浄装置の自動運転が停止する。

【0075】なお、上述した実施形態では、トレイ27 を手作業でクリーニングできるように構成しているが、 チャンバ2の内壁も手作業でクリーニングできるように 構成してもよい。また、上述した実施形態では、一つの 供給側マガジン7aに収容された全ての基板Aaの洗浄 処理が終了する毎に、手作業によるトレイ27のクリー ニングを要求する表示を行うようにしているが、他の周 期で(例えば、一回の洗浄処理が終了する毎や、あらか じめ設定された数の被洗浄物の洗浄が終了する毎)同様 の表示を行うようにしてもよい。また、この際、トレイ 27だけでなく、チャンパ2内の他の部分のクリーニン グも要求するようにしてもよい。

【0076】なお、本発明は上述した実施形態に限定さ れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で上 述した実施形態に種々の変形を施すことができる。

[0077]

【発明の効果】本発明のプラズマ洗浄装置は、チャンバ 内に被洗浄物が収容されていない状態でチャンバ内にプ 40 業でクリーニングを行うようにした場合を示す図。 ラズマ反応ガスを充填するとともに一対の電極間に高周 波電圧を印加してチャンバ内をクリーニングするクリー ニング手段を設けたことにより、チャンバ内に付着した 汚れがプラズマのエッチング作用により削り取られるた め、布が入りにくい細かい箇所に付着した汚れも除去す ることができる。また、汚れが透明な接着剤の場合に

は、プラズマにより化学的に変化して粉末状の固定とし て析出するため、視認可能になるとともに拭き取り易く なり、容易に除去することができる。したがって、チャ ンバ内に付着した汚れを効果的に除去することができる ものである.

【0078】また、請求項2のプラズマ洗浄装置は、ク リーニング手段が周期的にクリーニングを行うようにし たことにより、チャンバ内が汚れの少ない状態に保たれ るため製品の不良率が低減する。また、チャンバ内を手 10 作業でクリーニングする際に拭き取る汚れの量が少なく なるため、手間が低減する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施形態のプラズマ洗浄装置の全体構造を示 した斜視図。

【図2】 実施形態のプラズマ洗浄装置の全体構造を示 した斜視図。

【図3】 実施形態のプラズマ洗浄装置のチャンバの断 面図。

【図4】 図3の要部拡大図。

【図5】 実施形態のプラズマ洗浄装置による基板の処 理方法の説明図。

【図6】 実施形態のプラズマ洗浄装置の動作を示すフ ローチャート図であり、一回の洗浄処理が終了する毎に クリーニングを行う場合を示す図。

【図7】 実施形態のプラズマ洗浄装置の動作を示すフ ローチャート図であり、一つの供給側マガジンに収容さ れた全ての未処理基板の洗浄処理が終了する毎にクリー ニングを行う場合を示す図。

【図8】 実施形態のプラズマ洗浄装置の動作を示すフ 30 ローチャート図であり、あらかじめ設定された枚数の未 処理基板の洗浄処理が終了する毎にクリーニングを行う 場合を示す図。

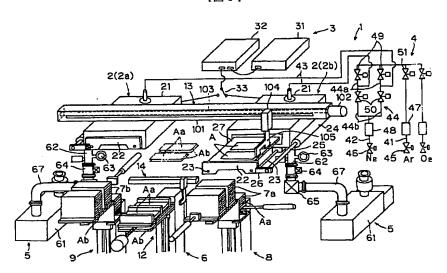
【図9】 実施形態のプラズマ冼净装置の動作を示すフ ローチャート図であり、一つの供給側マガジンに収容さ れた全ての未処理基板の冼净処理が終了する毎に手作業 でクリーニングを行うようにした場合を示す図。

【図10】 実施形態のプラズマ洗浄装置の動作を示す フローチャート図であり、一つの供給側マガジンに収容 された全ての未処理基板の洗浄処理が終了する毎に手作

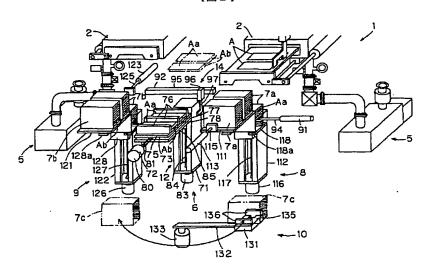
【符号の説明】

- 1 プラズマ洗浄装置
- 2 チャンバ
- 28 下部電極
- 29 上部電極

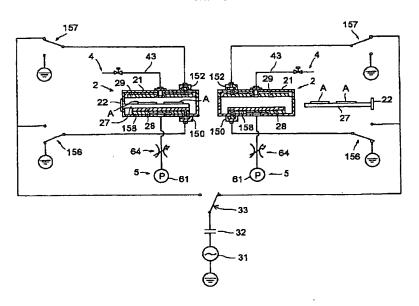
[図1]



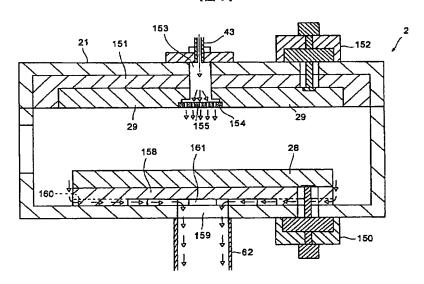
【図2】



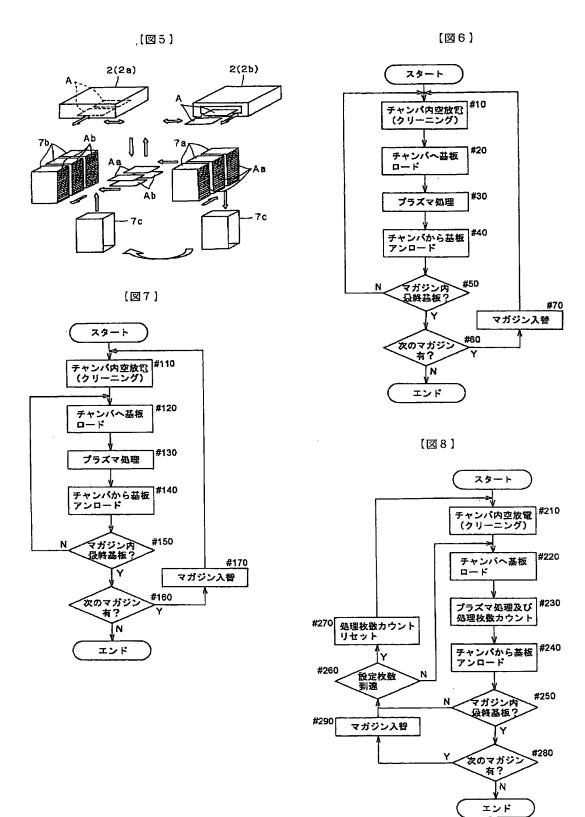
[図3]

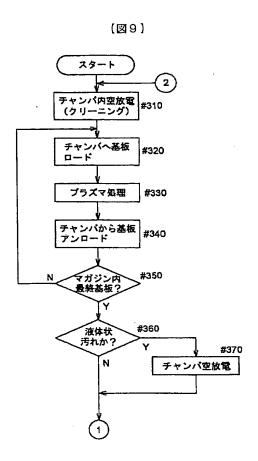


【図4】



- 0 " 0





チャンパ開 #380
トレークリーニング #390 #390 #390 #400 #440 #440 #440 #440 マガジン入替 アンド N エンド

[図10]